아주대학교 '반도체 소자 제작 공정' 교육시간표

일차	교육시간	교육내용
1일차 (8/26, 금)	09:00~10:30	Photolithography, Dry Etch & Wet Cleaning
	10:30~12:00	Ion Implantation & Diffusion, Oxidation & CMP
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	CMOS Integration @ASPEC
	14:00~16:00	
	16:00~18:00	Ajou Fab 소개 & Fab Tour
2일차 (8/27, 토)	09:00~10:30	F/I ~ Buffer Oxidation
	10:30~12:00	SiN Deposition & Densification
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	1.0 Active Patterning
	14:00~16:00	STI Etch Damage Curing
	16:00~18:00	STI Gap-Fill @PECVD Oxide
3일차 (8/29, 월)	09:00~10:30	1.5 Active-II Patterning
	10:30~12:00	
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	SiN Removal
	14:00~16:00	2.0 NW Photo
	16:00~18:00	3.0 PW Photo
4일차 (8/30, 화)	09:00~10:30	Well Annealing & Sacrificial Oxidation
	10:30~12:00	
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	Gate Oxidation & Poly-Si Deposition
	14:00~16:00	4.0 Gate Patterning
	16:00~18:00	
5일차 (8/31, 수)	09:00~10:30	5.0 N+SD Photo
	10:30~12:00	6.0 P+SD Photo
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	S/D Activation & ILD Deposition
	14:00~16:00	7.0 Contact Patterning & Al Evaporation
	16:00~18:00	
6일차 (9/1, 목)	09:00~10:30	8.0 Metal Patterning & Alloy (F/O)
	10:30~12:00	
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	Probe Station 사용법 교육
	14:00~16:00	전기적 특성 측정 및 분석(1)
	16:00~18:00	
7일차 (9/2, 금)	09:00~10:30	전기적 특성 측정 및 분석(2)
	10:30~12:00	
	12:00~13:00	중식
	13:00~14:00	전기적 특성 측정 및 분석(3)
	14:00~16:00	팀별 발표(1)
	16:00~18:00	팀별 발표(2) 및 과정 정리